

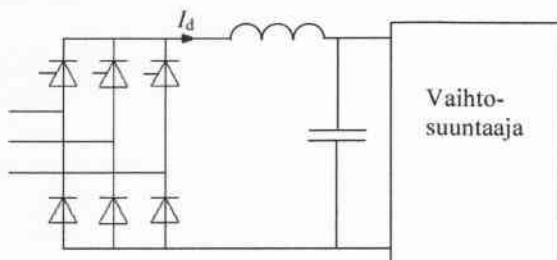
Papereihin

- sukunimi ja etunimet
- opiskelijanumero
- koulutusohjelma.

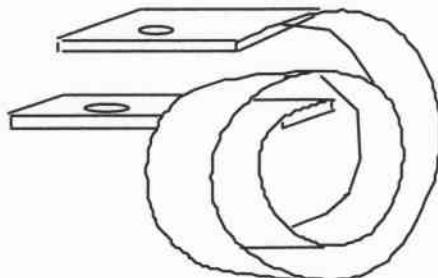
Tentissä sallitut apuvälaineet

- kynät, kumit jne.
- taskulaskin
- lukion kaavakokoelma tms. + Laplace taulut

1. Selvitä lyhyesti (max. 2...4 lausetta + mahdollinen kuva), mitä seuraavilla termeillä tarkoitetaan
 - SiC
 - takavirran varaus
 - SOA
 - bifiliaarinen käämitys
 - kuristimen hyvyysluku.
2. Esittele IGBT:n rakenne, toimintaperiaate ja ominaisuudet.
3. Selvitä, miten verkkotaajuiset ja suurtaajuiset muuntajat eroavat toisistaan. Kuvaille sanallisesti suurtaajuusmuuntajan (esim. 50 kHz, 100 W, 400 V/15 V) suunnittelun vaiheet ja kussakin vaiheessa huomioon otettavat seikat.
4. Kolmea tyristori/diodi -moduulia SKKH 57/16 E G6 (datalehti oheisenä) käytetään allaolevassa kolmivaiheisessa tasasuuntaajasillassa. Mikä on moduulien yhteen jäähdystyselementin lämpövastuksen $R_{th(s-a)}$ oltava, jotta silta kykenisi syöttämään 120 A tasavirran jäädytysilman lämpötilan ollessa 65 °C?



5. IGBT-taajuusmuuttajan lähtöjännitteen du/dt -suodattimeen tarvitaan 9 μH kuristimet. Kuristin on päättetty valmistaa ilmasydämisenä 2 x 30 mm poikkileikkaukseen omaavasta kuparinauhasta rullaamalla alla olevan kuvan tapaan. Kuristimen ulkohalkaisijan tulee olla pienempi kuin 18 cm. Kierrosten välisiin jätetään 2 mm eristysrako. Määräää kuristimen kierrosluku ja mitat. Tarvittava käyrästö ja kaavat löytyvät tehtäväpaperinipun lopusta.



SKKH 57/16 E G6



Thyristor / Diode Modules

SKKH 57/16 E G6

Features

- Heat transfer through aluminium oxide ceramic isolated metal baseplate
- UL recognized, file no. E63532

Typical Applications

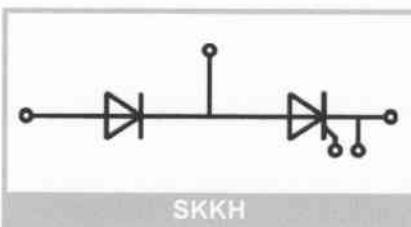
- DC motor control (e. g. for machine tools)
- AC motor soft starters
- Temperature control (e. g. for ovens, chemical processes)
- Professional light dimming (studios, theaters)

Absolute Maximum Ratings

Symbol	Conditions		Values	Unit
Chip				
I _{T(AV)}	sinus 180°	T _c = 85 °C T _c = 100 °C	61 45	A A
I _{TSM}	10 ms	T _j = 25 °C T _j = 130 °C	1500 1200	A A
I ² t	10 ms	T _j = 25 °C T _j = 130 °C	11250 7200	A ² s A ² s
V _{RSM}			1700	V
V _{RRM}			1600	V
V _{DRM}			1600	V
(di/dt) _{cr}		T _j = 130 °C	140	A/μs
(dv/dt) _{cr}		T _j = 130 °C	1000	V/μs
T _j			-40 ... 130	°C
Module				
T _{stg}			-40 ... 125	°C
V _{isol}	a.c.; 50 Hz; r.m.s.	1 min 1 s	3000 3600	V V

Characteristics

Symbol	Conditions	min.	typ.	max.	Unit
Chip					
V _T	T _j = 25 °C, I _T = 180 A		1.5	1.75	V
V _{T(TO)}	T _j = 130 °C		0.85	1	V
r _T	T _j = 130 °C		4.00	4.50	mΩ
I _{DD} ;I _{RD}	T _j = 130 °C, V _{DD} = V _{DRM} ; V _{RD} = V _{RRM}			20	mA
t _{gd}	T _j = 25 °C, I _G = 1 A, di _G /dt = 1 A/μs		1		μs
t _{gr}	V _D = 0.67 * V _{DRM}		2		μs
t _q	T _j = 130 °C		170		μs
I _H	T _j = 25 °C		150	250	mA
I _L	T _j = 25 °C, R _G = 33 Ω		300	600	mA
V _{GT}	T _j = 25 °C, d.c.	2.5			V
I _{GT}	T _j = 25 °C, d.c.	100			mA
V _{GD}	T _j = 130 °C, d.c.			0.25	V
I _{GD}	T _j = 130 °C, d.c.			4	mA
R _{th(j-c)}	cont.	per chip per module		0.420 0.210	K/W
R _{th(j-c)}	sin. 180°	per chip per module		0.440 0.220	K/W
R _{th(j-c)}	rec. 120°	per chip per module		0.460 0.230	K/W
Module					
R _{th(c-s)}	chip		0.22		K/W
	module		0.11		K/W
M _s	to heatsink M5		4.25	5.75	Nm
M _t	to terminals M5		2.55	3.45	Nm
a				5 * 9,81	m/s ²
w				75	g



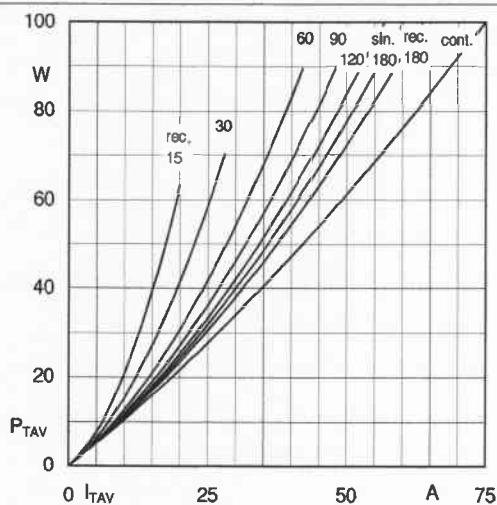


Fig. 1L: Power dissipation per thyristor/diode vs. on-state current

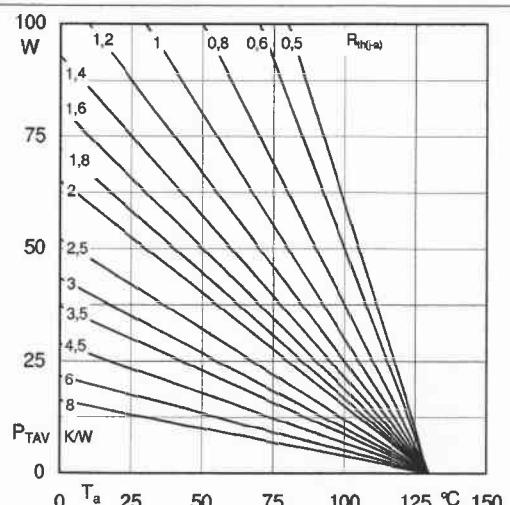


Fig. 1R: Max. power dissipation per chip vs. ambient temperature

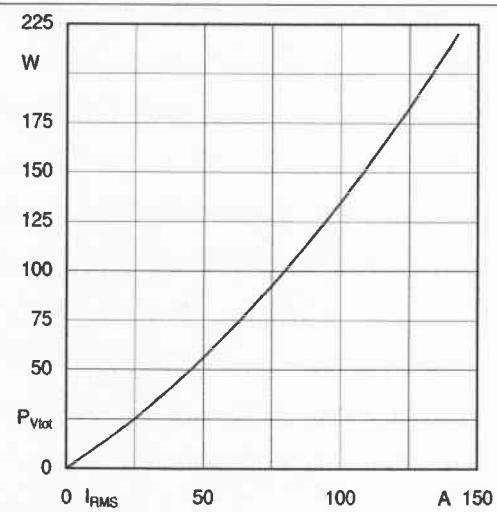


Fig. 2L: Max. power dissipation of one module vs. rms current

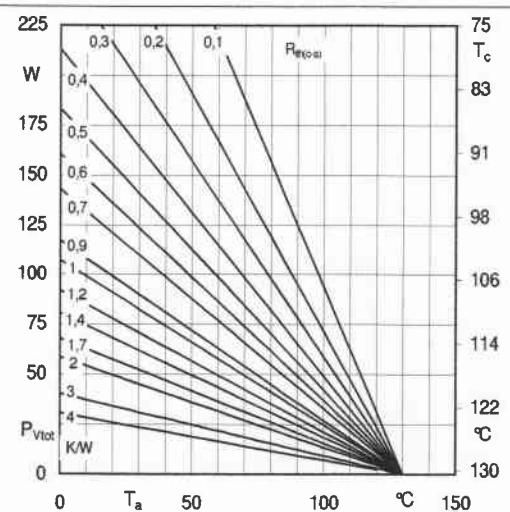


Fig. 2R: Max. power dissipation of one module vs. case temperature

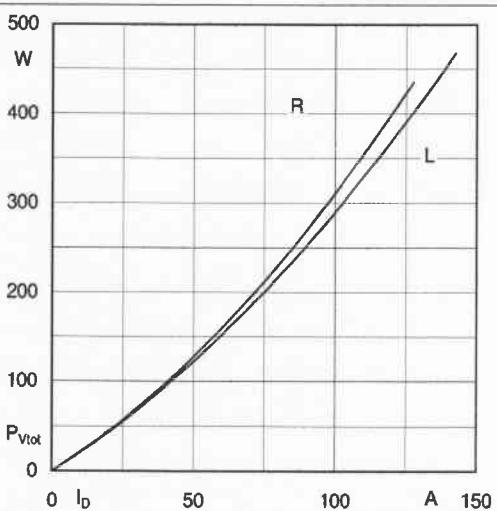


Fig. 3L: Max. power dissipation of two modules vs. direct current

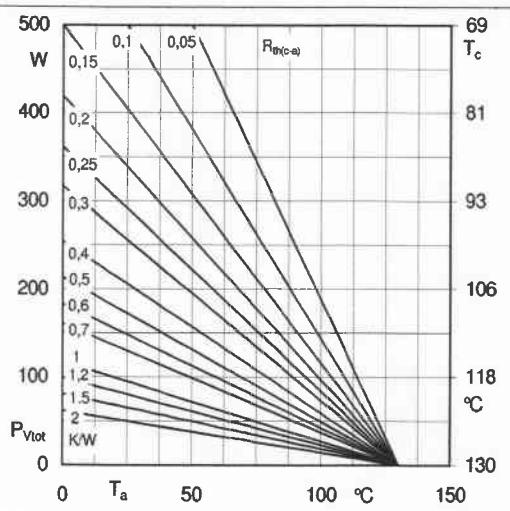


Fig. 3R: Max. power dissipation of two modules vs. case temperature

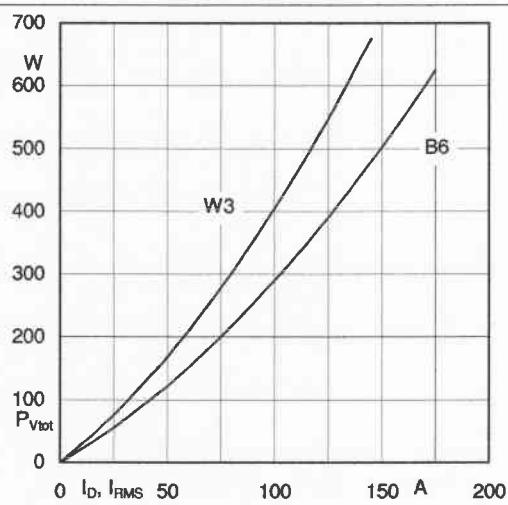


Fig. 4L: Max. power dissipation of three modules vs. direct current

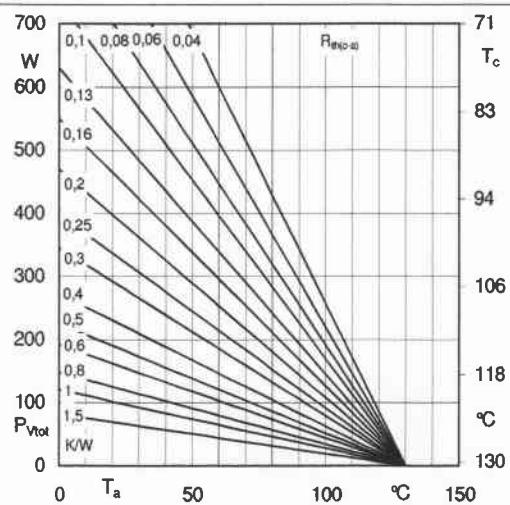


Fig. 4R: Max. power dissipation of three modules vs. case temperature

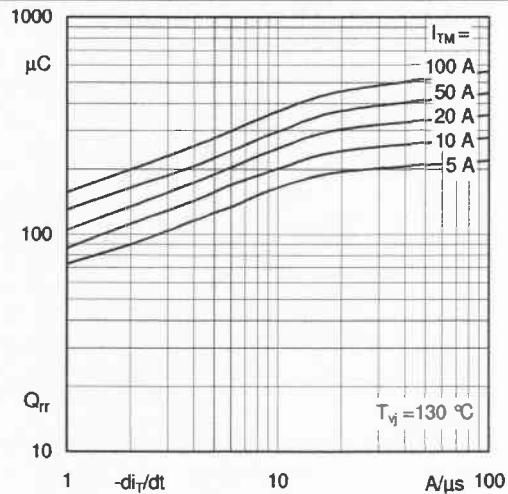


Fig. 5: Recovered charge vs. current decrease

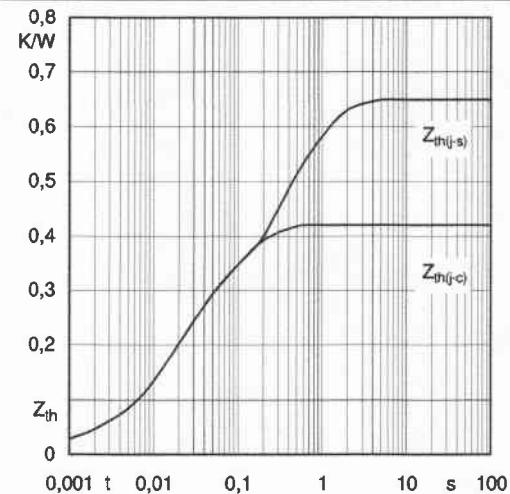


Fig. 6: Transient thermal impedance vs. time

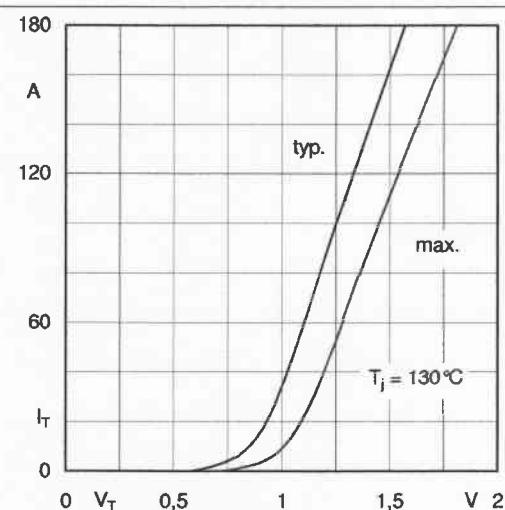


Fig. 7: On-state characteristics

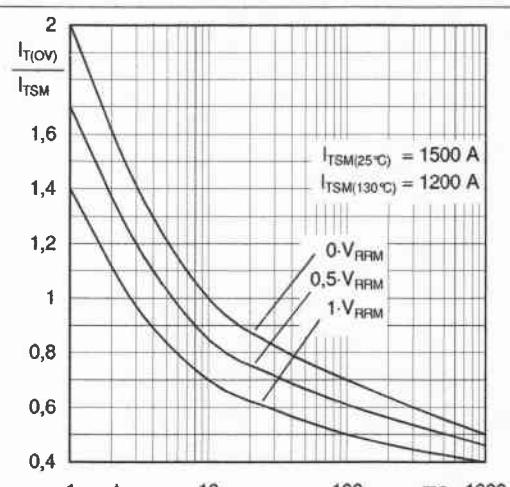


Fig. 8: Surge overload current vs. time

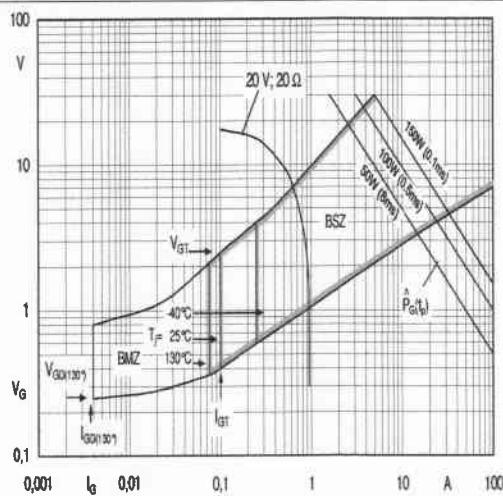
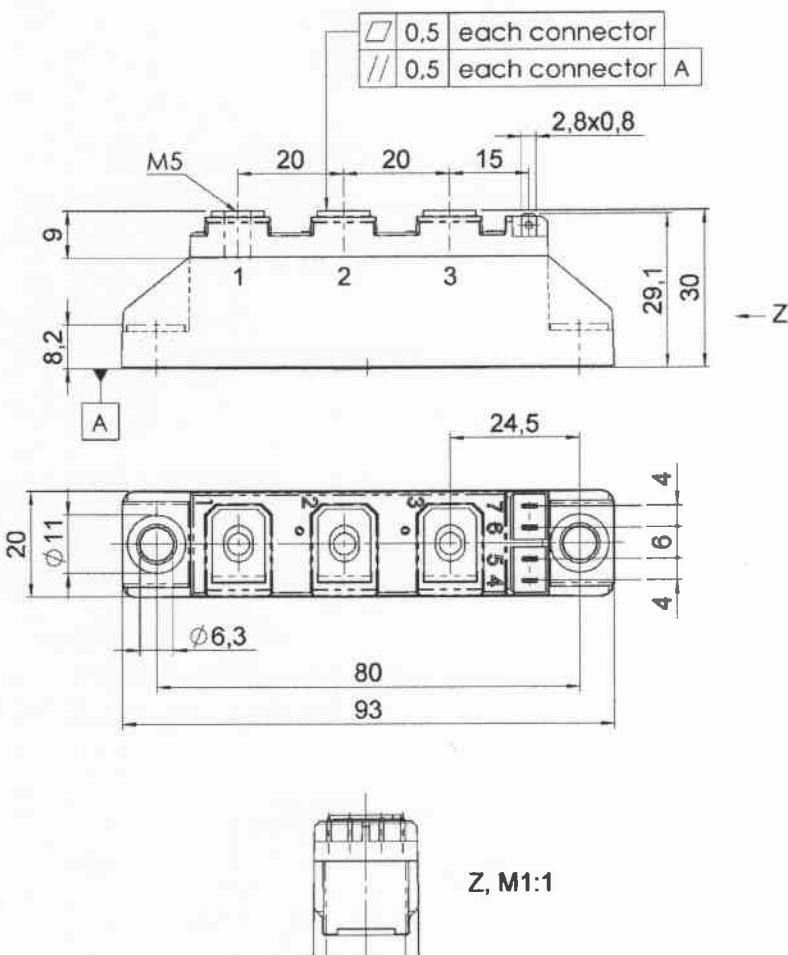
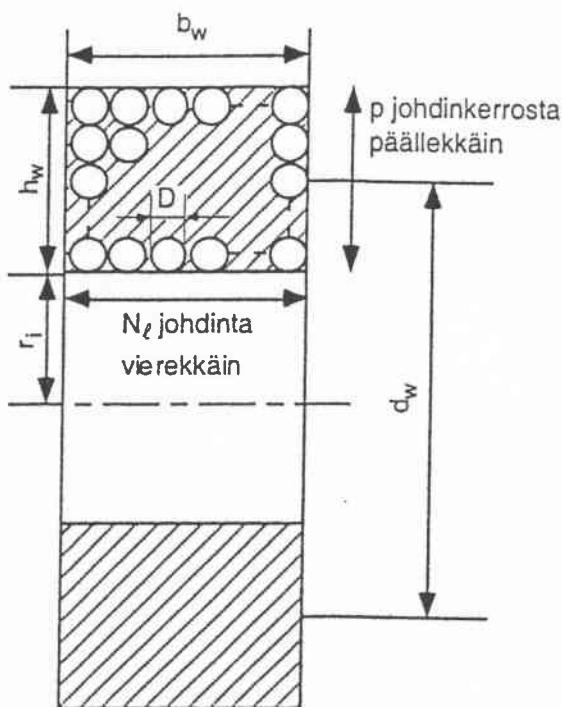


Fig. 9: Gate trigger characteristics



SEMIPACK 1

This technical information specifies semiconductor devices but promises no characteristics. No warranty or guarantee expressed or implied is made regarding delivery, performance or suitability.



Kuva 11.18. Ilmasydämisen kuristimen mitoituksessa tarvittavat mitat

$$\frac{L}{nH} = N^2 \phi(\eta, \zeta) \frac{d_w}{cm} \quad (11.38)$$

jossa

d_w = käämin keskihalkaisija

N = kierrosluku = $N_l p$

$\phi(\eta, \zeta)$ = kuvan 11.19 käyrästöstä saatava arvo

Kuvan 11.19 käyrästössä käytetyt muuttujat määritellään

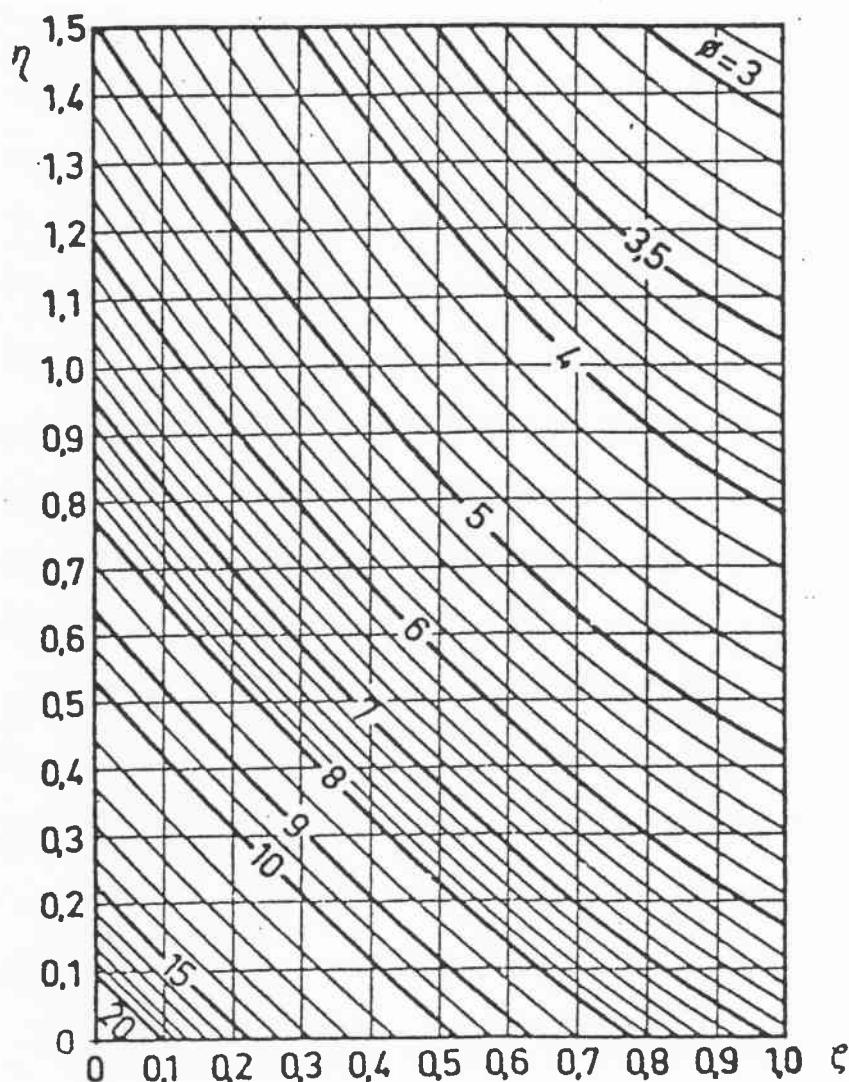
$$\eta = \frac{b_w}{d_w} = \frac{N_l D}{d_w} \quad (11.39)$$

$$\zeta = \frac{h_w}{d_w} = \frac{p D}{d_w} \quad (11.40)$$

joissa D on käämintään käytetyn johtimen keskimääräinen ulkohalkaisija, kuva 11.17., b_w käämin leveys ja h_w käämin korkeus.

Kuvassa 11.20 on esitetty johdinmenekin riippuvuus muuttujista η ja ζ . Optimia on merkitty luvulla 100. Kuten nähdään, optimipiste on saavutettavissa arvoparilla

$$\eta = \zeta \approx 0,34 \quad (11.41)$$



Kuva 11.19. Kuristimen ominaisinduktanssi ϕ muotomuuttujien η ja ζ funktiona /16/.

jolloin $\phi_{opt} \approx 8,3$. Optimialue on melko laaja. Sopivat arvovälit muotomuuttujille ovat siten

$$0,23 < \eta < 0,5$$

(11.42)

$$0,23 < \zeta < 0,5$$

Teht. 1-3: Katso kirja

Teht. 4

Datalehden kuvat 4L ja 4R pääterät kolmelle moduulleille. Kuvan 4L käyrä B6 päätee näistä tehtyn kuusipulssisiltaan. Vaaka-astekolla on valmiiksi I_D eli tasavirta. Siten piirtämällä pystysuora viiva kohtaan 120 A ja käyrän B6 leikkauuspisteestä vaakasuora viiva oikeanpuoleiseen käyrästöön nähdään että sen ja 65°C kohtaan piirretyn suoran leikkauuspisteessä on

$$R_{th(c-a)} \approx 0,095 \frac{\text{K}}{\text{W}}$$

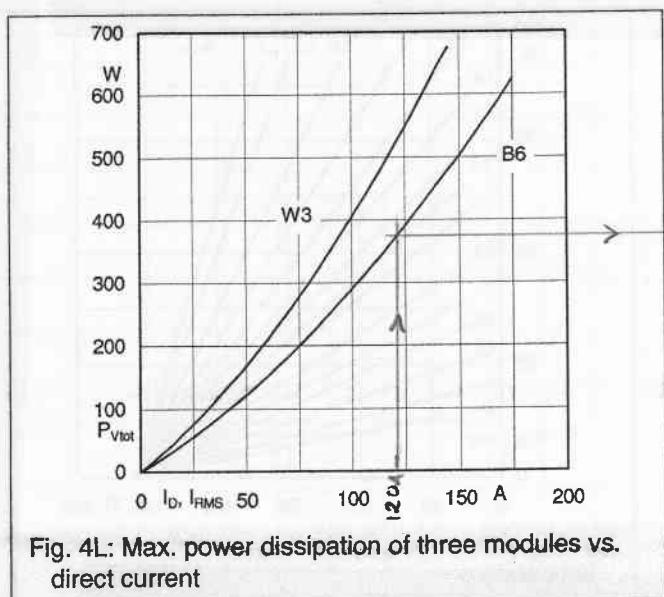


Fig. 4L: Max. power dissipation of three modules vs. direct current

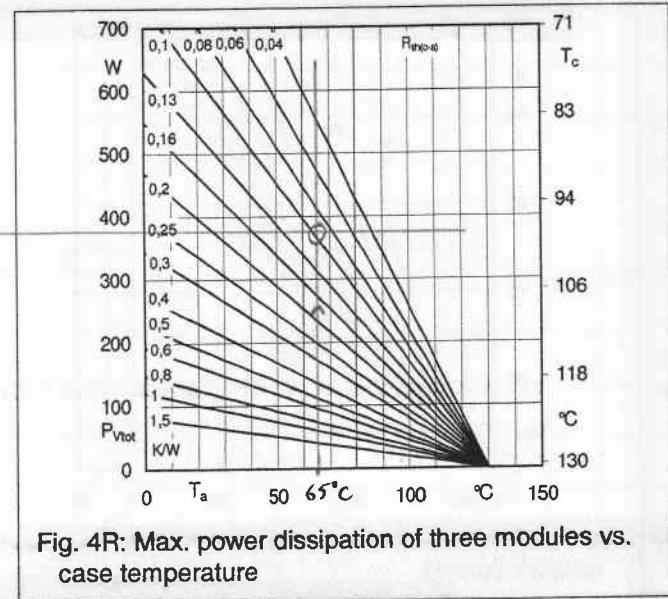


Fig. 4R: Max. power dissipation of three modules vs. case temperature

Datalehden sivulla 1 annetaan $R_{th(c-s)} = 0,11 \frac{\text{K}}{\text{W}}$ per moduuli. Nyt kyseessä on kolme moduulia, joten

$$\underline{\underline{R_{th(s-a)}}} \approx 0,095 \frac{\text{K}}{\text{W}} - \frac{0,11 \frac{\text{K}}{\text{W}}}{3} \approx 0,058 \frac{\text{K}}{\text{W}} \underline{\underline{R_{th(s-a)}}}$$

Teht. 5

Optimaalinen piste: $\phi = 8,3$ ja $\gamma = \varsigma = 0,34$

$$\Rightarrow N_{opt}^2 d_{w, opt} = \frac{L}{\phi_{opt}} \frac{\text{cm}}{nH} = \frac{9000}{8,3} \approx 1084 \text{ cm}$$

Kuparinauha on 30 mm levyistä $\Rightarrow b_w = 3 \text{ cm}$

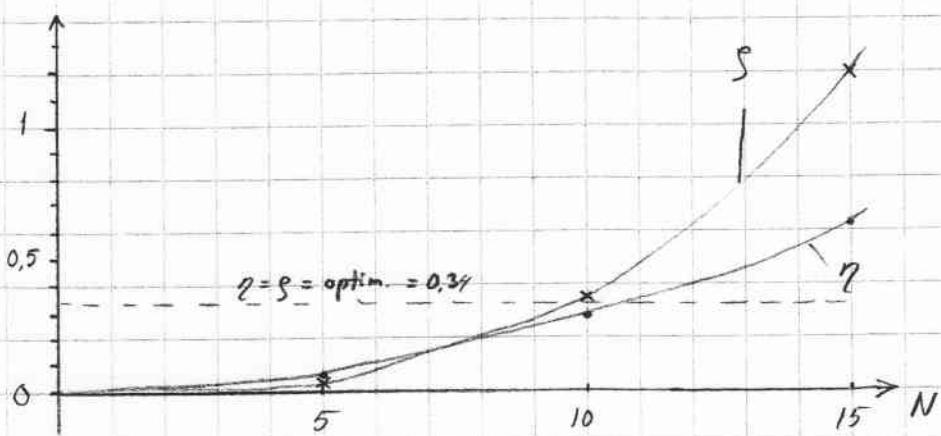
Käämin korkeus

$$h_w = N(2\text{mm} + 2\text{mm}) - 2\text{mm} = N \cdot 0,4 \text{ cm} - 0,2 \text{ cm}$$

↑ ↘ ↑
 kuparin paksuus eristysväli

Taulukoidaan: $d_{w, opt} = \frac{1084 \text{ cm}}{N^2}$

N	d_w / cm	γ	ς
5	43,3	0,069	0,042
10	10,84	0,277	0,351
15	4,8	0,625	1,208



Todetaan, että $N=10$ on läheinen optimi ς ja γ arvoja

$$\Rightarrow h_w = 10 \cdot 0,4 \text{ cm} - 0,2 \text{ cm} = 3,8 \text{ cm}$$

Tehtäväpaperin käyrästöstä saadaan

$$\phi(n, g) = \phi(0,277, 0,351) \approx 8,75 \frac{\text{nH}}{\text{cm}}$$

$$\Rightarrow L = N^2 \phi(n, g) \cdot dw = 10^2 \cdot 8,75 \cdot 10,84 = 9,485 \mu\text{H}$$

Menee siis noin 5% ylitse.

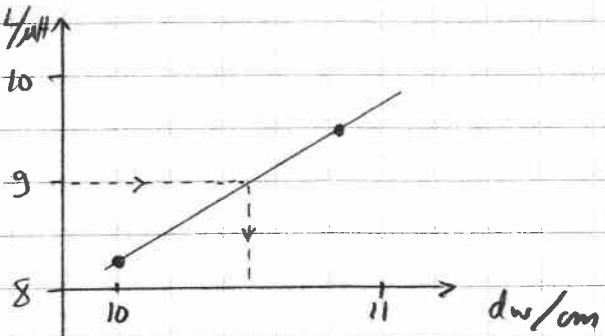
Kokeillaan arvoa $dw = 10 \text{ cm}$

$$\Rightarrow \eta = \frac{3 \text{ cm}}{10 \text{ cm}} = 0,3 \quad g = \frac{3,8}{10 \text{ cm}} = 0,38$$

$$\Rightarrow \phi(n, g) \approx 8,25$$

$$\Rightarrow L = 10^2 \cdot 8,25 \cdot 10 = 8,25 \mu\text{H}$$

Graafiseksi:



Siis keskihalkaisijan oltava noin 10,5 cm

$$\left(\text{tarkistus: } \eta = \frac{3}{10,5} = 0,286 \quad \right) \quad \left. \begin{array}{l} \phi(n, g) \approx 8,7 \\ g = \frac{3,8}{10,5} = 0,362 \end{array} \right\} \phi(n, g) \approx 8,7$$

$$\Rightarrow L \approx 10^2 \cdot 8,6 \frac{\text{nH}}{\text{cm}} \cdot 10,5 = 9,03 \mu\text{H} \Rightarrow \underline{\underline{\text{OK}}}$$

$$\text{Sisähalkaisija } d_i = 10,5 - 3,8 = 6,7 \text{ cm}$$

$$\text{Jotta johdin taipuisi, oltava } d_i \geq 6 \cdot 1 = 6 \cdot 2 \text{ mm} = 1,2 \text{ cm} \Rightarrow \underline{\underline{\text{OK}}}$$

$$\text{Ulkehalkaisija } d_o = 10,5 + 3,8 = 14,3 \text{ cm} < 18 \text{ cm} \Rightarrow \underline{\underline{\text{OK}}}$$